

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05232706 A

(43) Date of publication of application: 10.09.93

(51) Int. Cl

G03F 7/039
G03F 7/004
G03F 7/004
G03F 7/028
G03F 7/038
H01L 21/027

(21) Application number: 04073169

(22) Date of filing: 25.02.92

(71) Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

(72) Inventor: MURATA MAKOTO
OTA TOSHIYUKI
ISAMOTO YOSHITSUGU
MIURA TAKAO

(54) RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOUND

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a radiation sensitive resin compound, which presents excellent developing performance, pattern configuration, resolution, adhesiveness, focusing tolerance, and film remaining, ensures good stability, and can serve favorably for irradiation with radiations of wavelength under far-infrared ray, for example, excimer laser.

CONSTITUTION: A radiation sensitive resin compound comprises a positive type radiation sensitive resin compound and a negative type radiation sensitive resin

compound, wherein the former is composed of an alkaline soluble resin (1), radiation sensitive acid forming agent (2), a compound (3) having a nature of controlling the alkaline solubility of the alkaline soluble resin (1) and exhibiting a nature of diminishing or nullifying the alkaline solubility control effect of the resin (1) upon being dissolved under existence of acids or of accelerating the alkaline solubility of the resin (1) and (4): a nitrogen-including basic compound; and the latter composed of the same items: (1), (2), (4), and a compound (3) which is of nature as cross-linking the alkaline soluble resin (1) under existence of acids.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-232706

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51)Int.Cl.

G 0 3 F 7/039

7/004

識別記号

5 0 1

5 0 1

5 0 3

7/028

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

7352-4M

H 0 1 L 21/ 30 3 0 1 R

審査請求 未請求 請求項の数3(全18頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平4-73169

(22)出願日

平成4年(1992)2月25日

(71)出願人 000004178

日本合成ゴム株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者

村田 誠
東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

(72)発明者

大田 利幸
東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

(72)発明者

勇元 喜次
東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社内

(74)代理人

弁理士 大島 正孝

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】 (修正有)

【構成】 (1)アルカリ可溶性樹脂、(2)感放射線性酸形成剤、(3)(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または(1)のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物、および(4)含窒素塩基性化合物より構成されるポジ型感放射線性樹脂組成物 あるいは

(1)、(2)、(4)は上記と同じで(3)酸の存在下で(1)のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物より構成されるネガ型感放射線性樹脂組成物。

【効果】 現像性、パターン形状、解像度、接着性、フォーカス許容性および残膜性に優れ、安定性も良好であり、特にエキシマーレーザーなどの遠紫外線以下の波長の放射線の照射にも好適に使用される感放射線性樹脂組成物を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1) アルカリ可溶性樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、(3) (1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または

(1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物、および(4) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物。

【請求項2】 (1) 置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基を有するアルカリ不溶性または難溶性樹脂で、上記の基が酸解離したときにアルカリ可溶性である樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、および(3) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】 (1) アルカリ可溶性樹脂、(2) 感放射線性酸形成剤、(3) 酸の存在下で(1) のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物、および(4) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするネガ型感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、特にエキシマレーザーなどの遠紫外線の如き放射線を用いる微細加工に有用なレジストとして好適な感放射線性樹脂組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】集積回路の製造に代表される微細加工の分野においては、集積回路のより高い集積度を得るために、リソグラフィーにおける加工サイズの微細化がさらに進んでおり、近年では、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下の微細加工を安定的に行うことのできる技術が必要とされている。そのため、用いられるレジストにおいても、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下のパターンを精度良く形成することが必要である。しかし、従来の可視光線($700\text{~}400\text{ nm}$)または近紫外線($400\text{~}300\text{ nm}$)を用いる方法では、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下のパターンを精度良く形成することは極めて困難である。それ故、より波長の短い(300 nm 以下)放射線を利用したリソグラフィー技術が検討されている。

【0003】このような放射線としては、水銀灯の輝線スペクトル(254 nm)、KrFエキシマレーザー

(248 nm)などに代表される遠紫外線や、X線、電子線などを挙げることができる。これらのうち、特に注目されているのがエキシマレーザーである。このため、使用されるレジストに関しても、エキシマレーザーにより $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以下のパターンを高感度、高解像度で、パターンのプロファイルが良く、フォーカス許容性(放射

線照射時に焦点がずれても良好なパターンを保つことができる)、現像性(現像時のスカムや現像残りがない)、残膜性(現像時に膜減りしない)、接着性(現像時にレジストパターンが剥がれない)などの性能が優れていることが必要とされる。さらに、最近では、放射線照射によって酸を発生させ、その触媒作用により感度を向上させる「化学增幅型レジスト」が提案されている。これらのレジストにおいては、一般に、感度は良好であるが、安定性に問題があり、例えば放射線照射から現像までの時間や放射線照射後の加熱温度の違いなどにより性能が大きく変化するという問題がある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、新規な感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明の他の目的は、微細加工を安定的に行うことができ、高感度、高解像度で、パターンプロファイルが良く、フォーカス許容性、現像性、残膜性、密着性などの性能に優れ、安定性も良好であり、レジストとして好適な、感放射線性樹脂組成物を提供することにある。本発明のさらに他の目的は以下の説明から明らかとなろう。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、(1) アルカリ可溶性樹脂(以下、「樹脂(A)」という)、(2) 感放射線性酸形成剤(以下、「酸形成剤」という)、(3) (1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する性質を有し、そして酸の存在下で分解されて(1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または(1) のアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物(以下、「溶解制御剤」という)、および(4) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第1の発明」という)により達成される。

【0006】また、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第2に、(1) 置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基を有するアルカリ不溶性または難溶性樹脂で、上記の基が酸解離したときにアルカリ可溶性である樹脂(以下、「樹脂(B)」といふ)、(2) 酸形成剤、および(3) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするポジ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第2の発明」といふ)により達成される。

【0007】更に、本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第3に、(1) 樹脂(A)、(2) 酸形成剤、(3) 酸の存在下で(1) のアルカリ可溶性樹脂を架橋する化合物(以下、「架橋剤」といふ)、および(4) 含窒素塩基性化合物を含有することを特徴とするネガ型感放射線性樹脂組成物(以下、「第3の発明」といふ)

いう)により達成される。

[0008] 以下、本発明の組成物について説明する。

[0009] 樹脂 (A)

第1の発明および第3の発明で使用される樹脂(A)は、アルカリ現像液に可溶であるという性質を有するものであれば特に限定されない。従って、アルカリ現像液*

* と親和性を示す官能基、例えばフェノール性水酸基、カルボキシル基などの酸性官能基を有する樹脂であればよい。好適な樹脂(A)としては、例えば下記式(1)

[0010]

〔化1〕



ここで、 R^{01} は水素原子またはメチル基であり、
 R^{02} は、ヒドロキシル基、カルボキシル基、 $-R^{03}COOH$ 、
 $-OR^{05}COOH$ または $-OCR^{03}COOH$ であり、そして

R^{03} は $-(CH_2)_n-$ であり、
 n は 1~4 の整数である。

〔0 0 1 1〕で表わされる繰返し単位、下記式(2) ※【化2】
〔0 0 1 2〕 ※



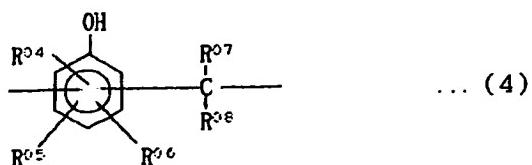
ここで、 R^{01} の定義は上記式(1)と同じである、

[0.013] で表わされる繰返し単位、下記式(3) 30★【化3】

[8814] ★



【0015】で表わされる繰返し単位および下記式
（4） ☆ 【0016】
☆ 【化4】



ここで、R⁰⁴、R⁰⁵、R⁰⁶、R⁰⁷およびR⁰⁸は、同一もしくは異なり、水素原子または炭素数1～4のアルキル基である。

【0017】で表わされる繰返し単位の少なくとも1つの繰返し単位を含有する樹脂を挙げることができる。

[0018] 本発明における樹脂(A)は、式(1)、
50 式(2)、式(3)または式(4)で表わされる繰返し

単位のみで構成されてもよいし、またその他の繰返し単位を有してもよい。ここにおけるその他の繰返し単位としては、例えば無水マレイン酸、マロニトリル、アクリルアミド、アクリロニトリル、ビニルピリジン、ビニルピロリドン、ビニルイミダゾール、ビニルアニリンなどの二重結合を含有するモノマーの二重結合が開裂した繰返し単位を挙げることができる。

【0019】本発明の樹脂(A)における式(1)、式(2)、式(3)および式(4)で表わされる繰返し単位の含有量は含有されるその他の繰返し単位により一概に決定できないが、通常、15モル%以上、好ましくは20モル%以上である。本発明の樹脂(A)の分子量は、ゲルパーキューションクロマトグラフィー(GPC)で測定したポリスチレン換算重量平均分子量(以下、「M_w」という)が、好ましくは1,000~150,000、特に好ましくは3,000~100,000である。

【0020】本発明の樹脂(A)を製造する方法としては、例えば対応するビニルモノマーを重合して得ることもできるし、あるいはフェノール類とアルデヒド類を重縮合して得ることもできる。これらの樹脂(A)のうち、式(1)または式(2)で表わされる繰返し単位を含有する樹脂は、水素添加率が70%以下、好ましくは50%以下、さらに好ましくは40%以下の水素添加物として用いることもできる。

【0021】樹脂(B)

第2の発明で用いられる樹脂(B)は、上述の樹脂(A)の酸性官能基のフェノール性水酸基またはカルボキシル基の水素原子を置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、アルコキシカルボニル基およびアシル基から選ばれる少なくとも1種の酸解離性基(以下、「置換基B」とする)で置換したアルカリ不溶性または難溶性樹脂である。ここで、酸解離性基とは酸の存在下で解離することが可能な基のことをいう。

【0022】置換基Bの具体例としては、メトキシメチル基、メチルチオメチル基、メトキシエトキシメチル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、ベンジルオキシメチル基、フェナシル基、ブロモフェナシル基、メトキシフェナシル基、α-メチルフェナシル基、シクロプロビルメチル基、シクロヘキシリ基、シクロペンチル基、ベンジル基、トリフェニルメチル基、ジフェニルメチル基、ブロモベンジル基、ニトロベンジル基、メトキシベンジル基、ピペロニル基などの置換メチル基；1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、イソプロビル基、t-ブチル基、1,1-ジメチルプロビル基などの1-置換エチル基；トリメチルゲルミル基、トリエチルゲルミル基、t-ブチルジメチルゲルミル基、イソプロビルジメチルゲルミル基、フェ

ニルジメチルゲルミル基などのゲルミル基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基；および

【0023】アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサノイル基、バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル基、ラウリロイル基、ミリストイル基、パルミトイyl基、ステアロイル基、オキサリル基、マロニル基、スクシニル基、グルタリル基、アジポイル基、ピペロイル基、スペロイル基、アゼラオイル基、セバコイル基、アクリロイル基、プロピオロイル基、メタクリル基、クロトノイル基、オレオイル基、マレオイル基、スマロイル基、メサコノイル基、カンホロイル基、ベンゾイル基、フタロイル基、イソフタロイル基、テレフタロイル基、ナフトイル基、トルオイル基、ヒドロアトロポイル基、アトロポイル基、シンナモイル基、フロイル基、テノイル基、ニコチノイル基、イソニコチノイル基、p-トルエンスルホニル基、メシル基などのアシル基を挙げることができる。

【0024】その中でもt-ブチル基、ベンジル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロチオフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基またはt-ブトキシカルボニル基が好ましい。

【0025】置換基Bの導入は、樹脂(A)の酸性官能基を介して行なわれ、置換基Bは、樹脂(A)の全酸性官能基に対し、好ましくは15~100%、さらに好ましくは30~100%導入する。樹脂(B)の分子量はGPCで測定したM_wが好ましくは1,000~150,000、特に好ましくは3,000~100,000である。

【0026】樹脂(B)はアルカリ不溶性または難溶性である。アルカリ難溶性とは、第2の発明を用いて形成されるレジスト皮膜にパターンを形成する際の好適なアルカリ現像条件において、当該レジスト皮膜の代わりに樹脂(B)のみの皮膜を用いて同様のアルカリ現像を行った場合に、樹脂(B)が初期膜厚の50%以上の膜厚で、当該操作後に残存する性質をいう。

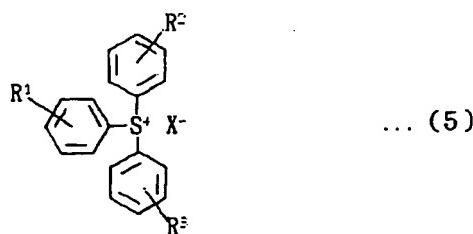
【0027】酸形成剤

本発明で用いられる放射線に感応して酸を発生する化合物、すなわち酸形成剤は、例えばオニウム塩、ハロゲン含有化合物、キノンジアジド化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物、ニトロベンジル化合物などであり、具体的には以下に示す化合物を例示することができる。

【0028】オニウム塩としては、例えばヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアソニウム塩、アンモニウム塩などを挙げることができ、好ましくは下記式(5)

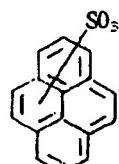
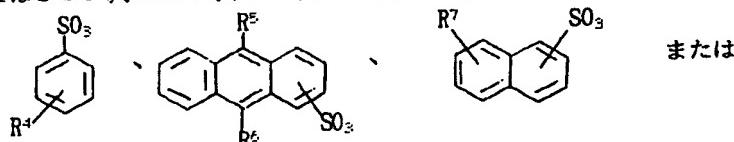
【0029】

【化5】



ここで、R¹、R²およびR³は、同一または異なり、水素原子、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、炭素数1～4のアルキル基または炭素数1～4のアルコキシ基であり、そして

XはSbF₆、AsF₆、PF₆、BF₄、CF₃CO₂、ClO₄、CF₃SO₃、



を示す。また、R⁴は水素原子、アミノ基、アニリノ基、

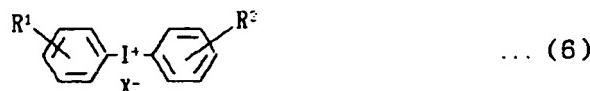
炭素数1～4のアルキル基または炭素数1～4のアルコキシ基であり、R⁵およびR⁶は炭素数1～4のアルコキシ基であり、R⁷は水素原子、アミノ基、アニリノ基、炭素数1～4のアルキル基または炭素数1～4のアルコキシ基である。

【0030】で表わされる化合物、下記式(6)

* 【化6】

【0031】

*



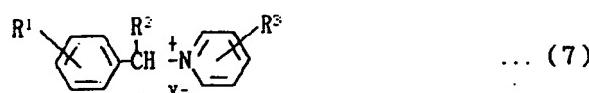
ここで、R¹、R²およびXの定義は上記式(5)と同じである、

【0032】で表わされる化合物および下記式(7)

* 【化7】

【0033】

*40



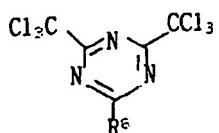
ここで、R¹、R²、R³およびXの定義は上記式(5)と同じである、

【0034】で表わされる化合物を挙げることができ
る。

ヘテロ環状化合物などを挙げることができ、好ましくは
下記式(8)

【0035】ハロゲン含有化合物としては、例え
ばハロアルキル基含有炭化水素系化合物、ハロアルキル基含有

50 【化8】



... (8)

ここで、R⁶はトリクロロメチル基、フェニル基、メトキシフェニル基、ナフチル基またはメトキシナフチル基である。

【0037】で表わされる化合物および下記式(9) *【化9】
【0038】 *10



ここで、R⁹、R¹⁰およびR¹¹は、同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子、メチル基、メトキシ基または水酸基である。

【0039】で表わされる化合物を挙げることができ
る。 *【0041】

【0040】キノンジアジド化合物としては、例えばジ
アゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物な※

※などを挙げることができ、好ましくは下記式(10)

【化10】



【0042】で表わされる化合物、下記式(11) ★【化11】

【0043】 ★

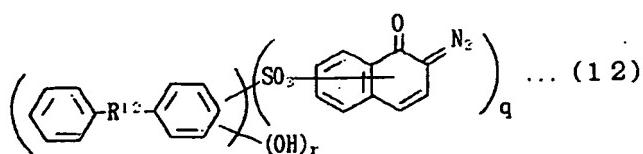
... (11)



【0044】で表わされる化合物、下記式(12) ★【化12】

【0045】 ★

... (11)

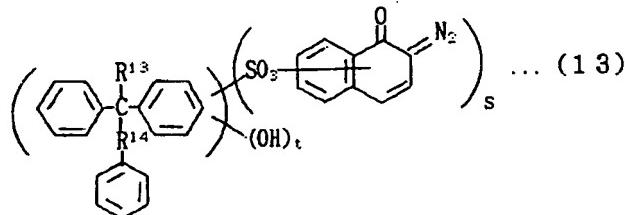


ここで、R¹²は-CH₂-、-C(CH₃)₂-、-C- または-SO₂-であり、qは1~6の整数であり、そしてrは0~5の整数である、ただしqとrの合計は1~6である。

11

【0046】で表わされる化合物および下記式(13) * 【化13】
【0047】 *

12



ここで、R¹³は水素原子またはメチル基であり、R¹⁴は-CH₂-、
-C(CH₃)₂-、-C=O- または -SO₃- であり、
sは1~6の整数であり、そしてtは0~5の整数である、ただし sとtの
合計は1~6である。

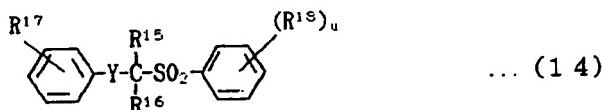
【0048】で表わされる化合物を挙げることができ
る。

*でき、好ましくは下記式(14)

【0050】

【0049】スルホン化合物としては、例えばβ-ケト
スルホン、β-スルホニルスルホンなどを挙げることが※20

【化14】



ここで、Yは-C=O- または -SO₃- であり、
R¹⁵、R¹⁶、R¹⁷およびR¹⁸は、同一または異なり、炭素数1~4のアルキ
ル基またはハロゲン原子であり、そして
nは0~3の整数である、

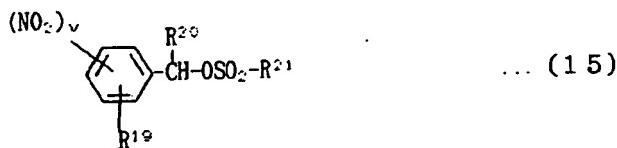
【0051】で表わされる化合物を挙げることができ
る。

ルホネート化合物などを挙げることができ、好ましくは
下記式(15)

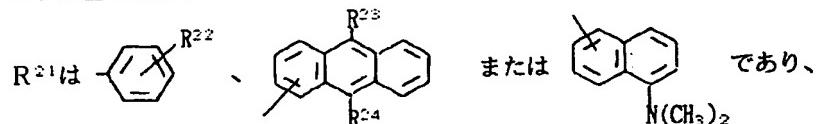
【0052】ニトロベンジル化合物としては、例え
トロベンジルスルホネート化合物、ジニトロベンジルス

【0053】

【化15】



ここで、R¹⁹は炭素数1～4のアルキル基であり、R²⁰は水素原子またはメチル基であり、



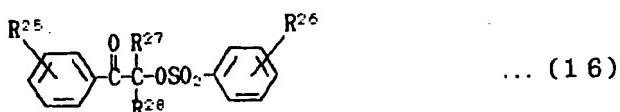
(ただし、R²²は水素原子またはメチル基であり、そしてR²³およびR²⁴は、同一または異なり、炭素数1～4のアルコキシ基である)、そしてnは1～3の整数である、

【0054】で表わされる化合物を挙げることができ
る。

【0055】スルホン酸化合物としては、例えばアルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、

*ル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホナートなどを挙げることができ、好ましくは下記式(16)

【0056】
【化16】



ここで、R²⁵およびR²⁶は、同一または異なり、水素原子または炭素数1～4のアルキル基であり、そしてR²⁷およびR²⁸は、同一または異なり、水素原子、炭素数1～4のアルキル基または炭素数6～20のアリール基である、

【0057】で表わされる化合物、下記式(17) ※【化17】

【0058】 ※



ここで、R²⁹は水素原子または炭素数1～4のアルキル基であり、そしてR³⁰およびR³¹は、同一または異なり、炭素数1～4のアルキル基または炭素数6～20のアリール基であるか、あるいはR³⁰とR³¹は互いに結合してそれらが結合している窒素原子と一緒にになって環を形成していてもよい、

【0059】で表わされる化合物および下記式(18) ★【化18】

【0060】 ★



ここで、Zはフッ素原子もしくは塩素原子である、

【0061】で表わされる化合物を挙げることができ

50 る。

【0062】これらのうち、オニウム塩およびキノンジアジド化合物が特に好ましい。これら酸形成剤の配合量は、上記樹脂(A)または樹脂(B)100重量部に対して、好ましくは1~70重量部であり、より好ましくは3~50重量部、さらに好ましくは3~20重量部である。1重量部未満では、十分なパターン形成能力が得られ難く、また70重量部を超えると、スカムを生じ易くなる。

【0063】溶解制御剤

第1の発明では、溶解制御剤が用いられる。該溶解制御剤は、それ自体がアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性を制御する効果を有し、そして酸の存在下で分解、例えば加水分解されてアルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解性制御効果を低下もしくは消失する性質または樹脂(A)のアルカリ溶解性を促進する性質を発現する化合物である*

*る。

【0064】該溶解制御剤としては、例えば酸性官能基に酸存在下にて遊離しうる置換基を導入した化合物が挙げられる。該置換基としては、特に限定されないが、例えば前記樹脂(B)にて述べた置換基Bまたはシリル基が挙げられる。ここで、シリル基の具体例としてはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、t-ブチルジメチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、フェニルジメチルシリル基などが挙げられる。

10 【0065】該溶解制御剤は、低分子化合物でもよく、高分子化合物でもよい。例えば、下記式(19)、式(20)、式(21)、式(22)および式(23)

【0066】

【化19】



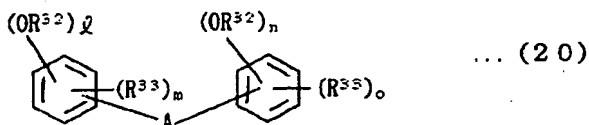
ここで、 R^{32} は、同一でも異なっていてもよく、置換メチル基、1-置換エチル基、ゲルミル基、シリル基、アルコキシカルボニル基、アシル基から選ばれる基であり、

R^{33} は複数存在する場合は、炭素数4以下のアルキル基、フェニル基またはナフチル基であり、そして

ℓ および m は、 $\ell + m \leq 6$ および $1 \leq \ell$ を満たす0以上の整数である、

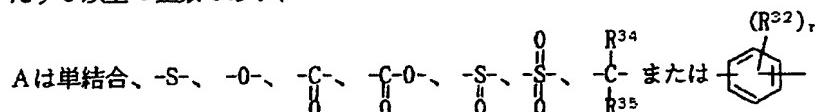
【0067】

※ ※ 【化20】



ここで、 R^{32} および R^{33} の定義は上記式(19)と同じであり、

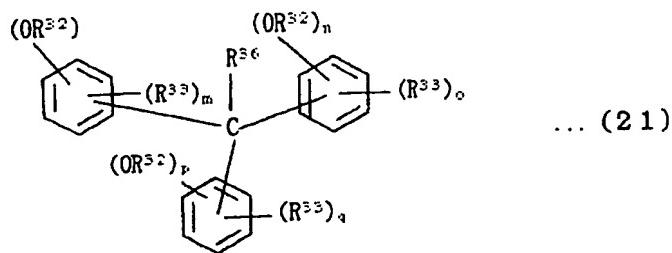
ℓ 、 m 、 n および t は、 $\ell + m \leq 5$ 、 $n + t \leq 5$ および $1 \leq \ell + n$ を満たす0以上の整数であり、



である（ただし、 R^{32} の定義は上記式(19)と同じであり、 R^{34} および R^{35} は水素原子、炭素数6以下のアルキル基、アシル基、フェニル基またはナフチル基であり、そして r は $0 \leq r \leq 4$ を満たす整数である）、

【0068】

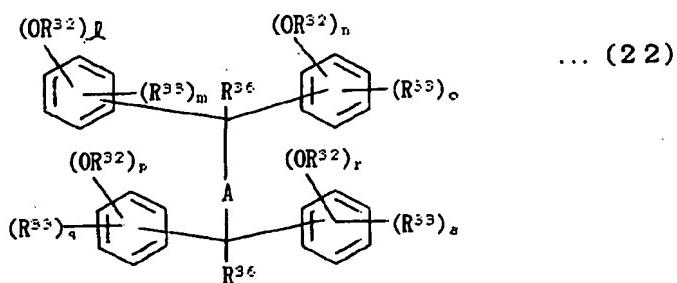
【化21】



ここで、 R^{32} および R^{33} の定義は上記式(19)と同じであり、
 ℓ 、 m 、 n 、 o 、 p および q は、 $\ell+m \leq 5$ 、 $o+n \leq 5$ 、 $p+q \leq 5$ および
 $1 \leq \ell+n+p$ を満たす0以上の整数であり、そして
 R^{36} は水素原子、炭素数4以下のアルキル基またはフェニル基である。

【0069】

* * 【化22】



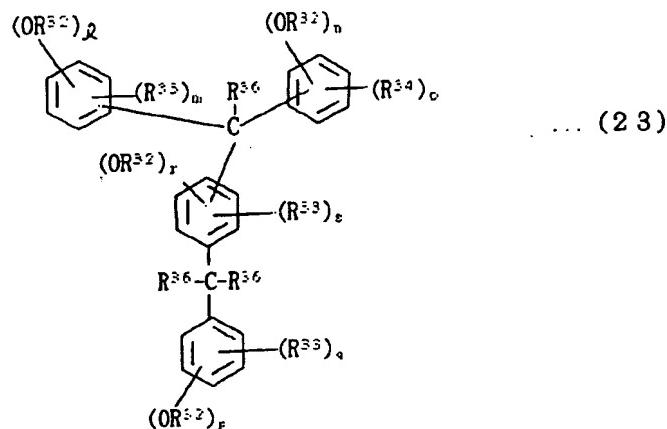
ここで、 R^{32} 、 R^{33} および R^{36} の定義は上記式(20)と同じであり、
 ℓ 、 m 、 n 、 o 、 p 、 q 、 r および s は、 $\ell+m \leq 5$ 、 $n+o \leq 5$ 、 $p+q \leq 5$ 、 $r+s \leq 5$ および $1 \leq \ell+n+p+r$ を満たす0以上の整数であり、

Aは単結合、 $-S-$ 、 $-O-$ 、 $-C-$ 、 $-C-O-$ 、 $-S-C-$ 、 $-C-S-$ 、 $-C-O-$ または $-C-R^{34}-$
 R^{35} または $-C(R^{32})_x-$

である（ただし、 R^{32} の定義は上記式(20)と同じであり、 R^{34} および
 R^{35} は水素原子、炭素数6以下のアルキル基、フェニル基またはナフチル基
 であり、そして x は $0 \leq x \leq 4$ を満たす整数である）。

【0070】

【化23】



ここで、 R^{32} 、 R^{33} 、 R^{34} および R^{36} の定義は上記式(21)に同じであり、そして ℓ 、 m 、 n 、 o 、 p 、 q 、 r および s は、 $\ell+m \leq 5$ 、 $p+q \leq 5$ 、 $n+o \leq 5$ 、 $r+s \leq 4$ および $1 \leq \ell+n+r+p$ を満たす0以上の整数である。

【0071】で表わされる化合物ならびに樹脂(A)に置換基Bまたはシリル基を導入した樹脂(以下、「樹脂C」という)を挙げることができる。

【0072】該溶解制御剤の配合量は、第1の発明において、樹脂(A)100重量部に対して、好ましくは5～150重量部、さらに好ましくは5～100重量部である。

【0073】含窒素塩基性化合物

本発明に使用される含窒素塩基性化合物は、好ましくは下記式(24)～(28)で表わされる構造の少なくとも1種の構造を分子内に有する化合物である。

【0074】

【化24】



ここで、 R^{37} 、 R^{38} および R^{39} は、同一または異なり、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のアミノアルキル基、炭素数1～6のヒドロキシアルキル基または炭素数6～20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{41} と R^{42} は互いに結合して環を形成してもよい。



(式中、 R^{40} 、 R^{41} 、 R^{42} および R^{43} は、同一または異なり、炭素数1～6のアルキル基を示す)

【0075】式(24)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、アンモニア、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、アニリン、N-メチルアニリン、N,N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロアニリン、1-ナフチルアミン、2-ナフチルアミン、ジフェニルアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ピロリジン、ピペリジンなどが挙げられる。

【0076】式(25)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、チアベンダゾールなどが挙げられる。

【0077】式(26)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、ピリジン、2-メチルピリジン、4-エチルピリジン、1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、ニコチン酸アミド、ジベンゾイルチアミン、四酔酸リボフラミンなどが挙げられる。

【0078】式(27)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノジフェニルアミン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフェニル)-2-

(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,4-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼンなどが挙げられる。

30 【0079】式(28)で表わされる構造を分子内に有する化合物の具体例としては、コハル酸ジメチル-1-(2-ヒドロキシエチル)-4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン重縮合物、ポリ{[6-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)イミノ-1,3,5-トリアジン-2,4-ジイル][2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル]イミノ]}、2-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2-n-ブチルマロン酸ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)などが挙げられる。

【0080】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物はの使用量は、樹脂(A)または樹脂(B)100重量部に対し、通常、0.001～10重量部、好ましくは0.01～5重量部である。0.001重量部未満ではパターン形状および接着性が悪化する傾向があり、一方10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0081】架橋剤

第3の発明では、架橋剤が用いられる。該架橋剤は、酸、例えば放射線照射により生じた酸の存在下で樹脂(A)を架橋する化合物である。上記性質を有する化合物であれば、該架橋剤は特に限定されないが、例えば架橋反応可能な置換基を有する芳香族化合物を好適なものとして挙げることができる。

【0082】例えば-C(R₄₄R₄₅)—O R₄₆基を有する芳香族化合物〔(但し、R₄₄およびR₄₅は、同一あるいは異なるアルキル基を表わし、R₄₆は水素原子あるいは炭素数1～4のアルキル基を表わす)、-COR₄₉基(但し、R₄₉は炭素数1～4のアルキル基または炭素数6～14のアリール基を表わす)〕、

【0083】-CO-R₅₀を有する芳香族化合物(但し、R₅₀は水素原子あるいは炭素数1～4のアルキル基を表わす)、-CR₅₁=CR₅₂R₅₃基を有する芳香族化合物(但しR₅₁、R₅₂およびR₅₃は、同一あるいは異なるアルキル基を表わす)などを挙げることができる。

【0084】これらの架橋反応可能な置換基としては、例えばグリシジルエーテル基、グリシジルエステル基、グリシジルアミノ基、メトキシメチル基、エトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、ジメチルアミノメチル基、ジエトキシメチルアミノ基、モルホリノメチル基、アセトキシメチル基、ベンゾイロキシメチル基、ホルミル基、アセチル基、ビニル基、イソプロペニル基などが挙げられる。

【0085】上記置換基を有する芳香族化合物としては、例えばビスフェノールA系エポキシ化合物、ビスフェノールF系エポキシ化合物、ビスフェノールS系エポキシ化合物、ノボラック系エポキシ化合物、レゾール樹脂系エポキシ化合物、ポリヒドロキシチレン系エポキシ化合物、メチロール基含有メラミン樹脂、メチロール基含有ベンゾグアナミン樹脂、メチロール基含有ユリア樹脂、メチロール基含有フェノール樹脂、メチロール基含有メラミン化合物、メチロール基含有フェノール化合物、アルキルエーテル基含有メラミン樹脂、アルキルエーテル基含有ベンゾグアナミン樹脂、アルキルエーテル基含有ユリア樹脂、アルキルエーテル基含有フェノール樹脂、アルキルエーテル基含有メラミン化合物、アルキルエーテル基含有フェノール化合物、カルボキシメチル基含有メラミン樹脂、カルボキシメチル基含有ベンゾグアナミン樹脂、カルボキシメチル基含有ユリア樹脂、カルボキシメチル基含有フェノール樹脂、カルボキシメチル基含有メラミン化合物、カルボキシメチル基含有フェノール化合物などが挙げられる。

【0086】このうち、メチロール基含有フェノール樹

脂、メチロール基含有フェノール化合物、メトキシメチル基含有メラミン化合物、メトキシメチル基含有フェノール化合物およびアセトキシメチル基含有フェノール化合物が好ましい。

【0087】架橋剤としては、さらに、樹脂(A)を上記に示す架橋反応可能な置換基で修飾して、架橋剤としての性質を付与したもの有利に使用できる。その場合の導入率は、樹脂(A)の酸性官能基の総量に対し、通常、5～60%、好ましくは10～50%、さらに好ましくは15～40%になるように調整される。5%以下では、十分な架橋反応を起こすことが困難で残膜率の低下、パターンの蛇行、膨潤などを招きやすく好ましくない。また、60%以上では、樹脂(A)のアルカリ可溶性の低下を招き現像性が悪化する傾向にある。

【0088】架橋剤の配合量は、樹脂(A)100重量部に対して、好ましくは5～95重量部、特に好ましくは15～85重量部、さらに好ましくは20～75重量部である。5重量部以下では、十分な架橋反応を起こすことが困難で残膜率の低下、パターンの蛇行、膨潤などを招きやすい。また、95重量部以上では、スカムが多く現像性が悪化する傾向にある。

【0089】本発明の組成物においては、さらに必要に応じて、種々の添加剤を配合することができる。このような添加剤としては、例えば塗布性、ストリエーションや乾燥塗膜形成後の放射線照射部の現像性などを改良するための界面活性剤を挙げることができる。この界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート、市販品としては、例えばエフトップEF301、EF303、EF352(新秋田化成(株)製)、メガファックスF171、F173(大日本インキ(株)製)、フローラードFC430、FC431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)、オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化学工業(株)製)、アクリル酸系またはメタクリル酸系(共)重合体であるポリフローNo.75、No.95(共栄社油脂化学工業(株)製)などが用いられる。

【0090】界面活性剤の配合量は、前記樹脂(A)または樹脂(B)100重量部当り、通常、2重量部以下である。その他の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保安安定剤、消泡剤などを挙げることができる。

【0091】本発明の組成物は、前述した樹脂(A)または酸形成剤および必要により配合される各種添加剤

を、それぞれ必要量、溶剤に溶解させることによって調製される。

【0092】この際に用いられる溶剤としては、例えばエチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、2-エトキシエチルアセテート、プロピレンジコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレンジコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレンジコールモノブロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプタノン、シクロヘキサン、2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー-3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキシブチオニ酸メチル、3-エトキシブチオニ酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メチルピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミドなどを挙げることができる。

【0093】また、これらの溶剤には、必要に応じてベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カブリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γ -ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルブアセテートなどの高沸点溶剤を添加することもできる。

【0094】本発明の組成物は、上記の溶液の形でシリコンウェハーなどの基板上に塗布し、乾燥することによってレジスト膜を形成する。この場合、基板上への塗布は、例えば本発明の組成物を固体分濃度がで5~50重量%となるように前記の溶剤に溶解し、濾過した後、これを回転塗布、流し塗布、ロール塗布などにより塗布することによって行われる。

【0095】形成されたレジスト膜には、微細パターンを形成するために部分的に放射線が照射される。用いられる放射線には特に制限はなく、例えばエキシマレーザーなどの遠紫外線、シンクロトロン放射線などのX線、電子線などの荷電粒子線のような放射線が、使用される

酸形成剤の種類に応じて用いられる。放射線量などの照射条件は、組成物の配合組成、各添加剤の種類などに応じて適宜決定される。

【0096】本発明においては、レジストのみかけの感度等を向上させるために、放射線照射後に加熱を行なうことが好適である。この加熱条件は、組成物の配合組成、各添加剤の種類などによって異なるが、通常、30~200°C、好ましくは50~150°Cである。

【0097】次いで行われる現像に使用される現像液としては、レジストパターンを得るために、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、n-ブロピルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-ブロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ビペリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノナンなどを溶解してなるアルカリ性水溶液などを使用することができる。

【0098】また、上記現像液に水溶性有機溶媒、例えばメタノール、エタノールなどのアルコール類や界面活性剤を適宜添加したアルカリ性水溶液を現像液として使用することもできる。さらに現像液として、クロロホルム、ベンゼンなどを使用することができ、この場合はネガ型のレジストパターンを得ることができる。

【0099】

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。実施例中、各種の特性は次のようにして評価した。

【0100】最適露光量

0.4 μmのラインアンドスペースが設計通りにパターン形成できる露光量。

解像度

最適露光量を与えた時に分離しているラインアンドスペースの最小サイズ。

パターン形状

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの方形状断面の下辺長Aと上辺長Bを測定し、 $0.85 \leq B/A \leq 1$ である場合をパターン形状が良好であると判断した。ただし、パターン形状が裾を引いていたり、逆テーパー状になっている場合は、B/Aが上記範囲に入っていても不良と判断した。

【0101】フォーカス許容性

ステッパーの焦点をずらして露光した場合に、上記に定義した良好なパターン形状を保つことができる焦点のずれの範囲。

安定性

露光後、2時間放置してから露光後ベークを行い、最適

露光量およびパターン形状を評価した。

接着性

走査型電子顕微鏡を用い、レジストパターンの剥がれの程度を調べた。

【0102】Mw：東ソー社製GPCカラム(G2000H_{XL} 2本、G3000H_{XL} 1本、G4000H_{XL} 1本)を用い、流量1.0mL/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40°Cの分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーキューションクロマトグラフ法により測定した。

【0103】実施例1

ポリヒドロキシスチレン30gをテトラヒドロフランに溶解して、カリウムt-ブトキシド10gを添加し、攪拌下、0°Cにおいて、ジ-t-ブチカルボネート75gを滴下し、6時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50°Cで一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=30,000、Mw/Mn=1.60で、NMR測定の結果からフェノール性水酸基の水素の63%がt-ブトキシカルボニル基で置換された構造であった。

【0104】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.2gおよびジアミノジフェニルメタン0.02gを3-メトキシプロピオニ酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、100°Cで2分間ベーリングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0105】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを30mJ.c⁻²照射した後、90°Cで2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23°Cにて現像し、次いで水で30秒間リソルブした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150°Cのホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

【0106】比較例1

実施例1で用いた組成物溶液において、ジアミノジフェニルメタンを添加しない組成物溶液を調製し、エキシマレーザーの照射量を変化させた以外は同様にしてパターン形成を行った。結果を表1に示した。5mJ.c⁻²照射した場合に0.35μmのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン上部において底が張り出すような形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を2時間とした場合には、表面に不溶層が形成し、パターンを解像することができなかった。

【0107】実施例2

ポリヒドロキシスチレン54gをアセトンに溶解して、t-ブチル-α-ブロモ酢酸27g、炭酸カリウム10

gおよびヨウ化カリウム9gを添加し、攪拌下、還流を続けながら、7時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50°Cで一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=18,000、Mw/Mn=1.87で、NMR測定の結果からフェノール性水酸基の水素の22%がt-ブチル酢酸残基で置換された構造であった。

【0108】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.1gおよび

10 ニコチン酸アミド0.02gを3-メトキシプロピオニ酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90°Cで2分間ベーリングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0109】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248nmのエキシマレーザーを52mJ.c⁻²照射した後、100°Cで2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で6

20 0秒間、23°Cにて現像し、次いで水で30秒間リソルブした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150°Cのホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

【0110】比較例2

実施例2で用いた組成物溶液において、ニコチン酸アミドを添加しない組成物溶液を調製し、同様にパターン形成を行った。表1に示したように、表面に不溶層が形成し、パターンを形成することができなかった。

【0111】実施例3

マレイン酸とスチレンとの共重合体107gを酢酸エチルに溶解して、3,4-ジヒドロ-2H-ピラン50gとp-トルエンスルホン酸0.1gを添加し、攪拌下、5°Cにおいて、3時間反応した。反応終了後、この溶液を蒸留水と混合し、分液ロートを用いてp-トルエンスルホン酸を抽出した後、ヘキサン中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50°Cで一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=11,000、Mw/Mn=2.1で、NMR測定の結果からマレイン酸のカルボニル酸のうち52%がテトラヒドロピラニル基で置換された構造であった。

【0112】このポリマー10gとトリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート0.2gおよびチアベンダゾール0.03gを3-メトキシプロピオニ酸メチル31gに溶解した後、0.2μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、100°Cで2分間ベーリングを行い、膜厚1.0μmのレジスト膜を形成した。

【0113】形成したレジスト膜にステッパーを用い

て、波長248 nmのエキシマレーザーを38 mJ·c⁻²照射した後、90°Cで2分間露光後ベークを行い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23°Cにて現像し、次いで水で30秒間リノスした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを140°Cのホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

【0114】比較例3

実施例3で用いた組成物溶液において、チアベンダゾールを添加しない組成物溶液を調製し、エキシマレーザーの照射量を変化させた以外は実施例3と同様にしてパターン形成を行った。結果を表1に示した。5 mJ·c⁻²照射した場合に、0.4 μmのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン上部において底が張り出すような形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を2時間とした場合には、表面に不溶層が形成し、パターンを解像することができなかった。

【0115】実施例4

クレゾールノボラック (m-/p-=6/4) 54 gをアセトンに溶解して、t-ブチル-α-ブロモ酢酸2.7 g、炭酸カリウム1.0 gおよびヨウ化カリウム9 gを添加し、攪拌下、還流を続けながら、7時間反応した。反応終了後、この溶液を水中に滴下し、析出したポリマーを真空乾燥器にて50°Cで一晩乾燥した。得られたポリマーは、Mw=5,600、Mw/Mn=4.8で、NMR測定の結果からフェノール性水酸基の水素の22%がt-ブチル酢酸残基で置換された構造であった。

【0116】このポリマー1.0 gとトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.1 gおよびニコチン酸アミド0.02 gを3-メトキシプロピオン酸メチル3.1 gに溶解した後、0.2 μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90°Cで2分間ベーキングを行い、膜厚1.0 μmのレジスト膜を形成した。

【0117】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248 nmのエキシマレーザーを31 mJ/c⁻²照射した後、100°Cで2分間露光後ベークを行

い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23°Cにて現像し、次いで水で30秒間リノスした。形成されたポジ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150°Cのホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

【0118】実施例5

ポリヒドロキシスチレン (Mw=9,000) 1.0 g、2,6-ビスマチロール-p-クレゾール4 g、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート0.3 gおよびジアミノジフェニルエーテル0.03 gを3-メトキシプロピオン酸メチル3.1 gに溶解した後、0.2 μmのフィルターで濾過して組成物溶液を調製した。調製した組成物溶液を、シリコンウェハー上に塗布した後に、90°Cで2分間ベーキングを行い、膜厚1.0 μmのレジスト膜を形成した。

【0119】形成したレジスト膜にステッパーを用いて、波長248 nmのエキシマレーザーを1.5 mJ·c⁻²照射した後、100°Cで2分間露光後ベークを行
い、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間、23°Cにて現像し、次いで水で30秒間リノスした。形成されたネガ型パターンは、表1に示したように良好な結果を与えた。さらにこのレジストパターンを150°Cのホットプレート上で2分間加熱したところ、パターン形状の変化は認められなかった。

【0120】比較例4

実施例5で用いた組成物溶液において、ジアミノジフェニルエーテルを添加しない組成物溶液を調製し、エキシマレーザーの照射量を変化させた以外は実施例5と同様にしてパターン形成を行った。結果を表1に示した。5 mJ·c⁻²照射した場合に、0.4 μmのラインアンドスペースパターンが解像されたが、パターン表面において異物（直径0.02~0.05 μm程度の粒子状の突起物）が生成し、微細加工には好ましくない形状であった。また、露光から露光後ベークまでの間隔を6時間とした場合には、5 mJ·c⁻²の露光量では、設計寸法0.4 μmのパターンが0.6 μmで形成されていた。

【0121】

【表1】

表1

	露光直後に露光後ペークを行った場合				安定性		
	最適露光量 (mJ・cm ⁻²)	解像度 (μm)	パターン形状	接着性	フォーカス 許容性 (μm)	最適露光量 (mJ・cm ⁻²)	パターン形状
実施例1	3.0	0.3	良好	良好	1.2	2.9	良好
実施例2	2.7	0.3	良好	良好	1.5	2.5	良好
実施例3	3.8	0.3	良好	良好	1.2	3.8	良好
実施例4	3.1	0.3	良好	良好	1.2	3.0	良好
実施例5	1.5	0.35	良好	良好	1.2	1.8	良好
比較例1	5	0.35	不良	不良	0.6	—	形成できず
比較例2	—	—	不良	不良	—	—	形成できず
比較例3	1.0	0.4	不良	不良	0.3	—	形成できず
比較例4	5	0.4	異物	良好	0.9	3	異物

1. パターン形状、接着性、フォーカス許容性は0.4 μmのラインアンドスペースでの結果

【0122】

【発明の効果】現像性、パターン形状、解像度、接着性、フォーカス許容性および残膜性に優れ、安定性も良* * 好であり、特にエキシマーレーザーなどの遠紫外線以下の波長の放射線の照射にも好適に使用される感放射線性樹脂組成物を提供する。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.5

G 03 F 7/038

H 01 L 21/027

識別記号

505

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

(72) 発明者 三浦 孝夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
成ゴム株式会社内